

Simuleringsprogram

1. Vladimirescu, Zhang, Newton and Pederson, *SPICE2G-User's Guide*, University of California, Berkeley, 1981.
2. T. Rübner-Petersen, *NAP2-User's Manual*, Danmarks Tekniska Högskola.
3. E. Lindberg, *NAP2 and SPICE2, A comparison*, Danmarks Tekniska Högskola, 1981.

Sakregister/Ordlista

abrupt approximation	60	abrupt junction approximation
absorptionsdjup	127	absorption depth
absorptionskoefficient	127	absorption coefficient
acceptor	13	acceptor
acceptornivå	22	acceptor (impurity) level
ackumulation	203, 279	accumulation
affinitet	44	affinity
aktiveringsenergi	324, 326, 330	activation energy
alstringstakt	45	generation rate
aluminium	348	aluminum
andra ordningens effekter	158	second-order effects
bipolärt	158	bipolar
MOS	219	MOS
anrikningstransistor	216	enhancement transistor
arsenik	328	arsenic
atom	14	atom
avancerad Schottky-logik	191	Advanced Schottky Logic (AS-TTL)
avkodare	250	decoder
backspänning	65	reverse bias
badkarskurvan	368	bathtub failure curve
bandgap	16	bandgap
direkt	20	direct
indirekt	20	indirect
bandgapsreferens	174	bandgap voltage reference
bas	146	base
basdiffusion	178	base diffusion
basresistans	158	base-spreading resistance
bastransportfaktor	152	base transport factor
basviddmodulation	159	base-width modulation
belastningslinje	157	load line
bipolär transistor	146	bipolar transistor
dimensionering och tillverkning	178	design and fabrication

Ebers-Moll	152	Ebers-Moll	karakteristik	80	characteristic
Gummel-Poon	175	Gummel-Poon	Schottky	117	Schottky
hybrid- π	171	hybrid- π	varaktor	120	varaktor
transportmodellen	151	transport model	zener	101	zener
Bohrs atommodell	14	Bohr's atom model	återhämtningstid	112	recovery time
Boltzmannfördelning	36	Boltzmann distribution	diod-transistor logik	121	Diode Transistor Logic (DTL)
Boltzmanns konstant	21, 376	Boltzmann's constant	djup utarmning	286	deep depletion
bondning	363	(wire) bonding	DMOS	263	Double-diffused MOS
termokompression	364	thermocompression	donator	13	donor
ultraljud	364	ultrasonic	donatornivå	22	donor impurity level
bor	13, 328	boron	dopning	12	doping
bottendiffusion	181	buried layer	dopningskoncentration	331	impurity concentration
bottning	154	saturation	dopningsprofil	331	doping profile
bredd/längdförhållande	212	aspect ratio	Gaussisk	331	Gaussian
bricka	307	chip, die	erfc	331	erfc
brickmontering	363	die bonding	dopningsprofilmätning	98, 289	impurity profile measurement
bromsning	339	stopping power	drain	201	drain
elektronisk	339	electronic	DRAM	254	Dynamic Random Access Memory
nukleär	339	nuclear	drift	27	drift
BT-stress	286	Bias-Temperature Stress	driftström	9	drift current
CCD	261	Charge-Coupled Devices	drivförmåga	239	driving capability
CDI	185	Collector Diffusion Isolation	DTL	121	Diode Transistor Logic
CMOS	238	Complementary MOS	D-vippa	245	D-latch
CVD	342	Chemical Vapor Deposition	dynamisk	dynamic	dynamic
CV-kurva	280	CV-curve	effektförbrukning	236	power dissipation
Czochralski-metoden	314	Czochralski method	jämvikt	21	equilibrium
Darlington	141	Darlington	kapacitans	94	capacitance
Debyelängd	70	Debye-length	RAM-minne	254	DRAM
degenererat kisel	40	degraded silicon	resistans	84	resistance
depletion-transistor	216	depletion transistor	Earlyspänning	160	Early-voltage
deponering	342	predeposition	Ebers-Molls transistormodell	152	Ebers-Moll transistor model
diamantstruktur	11	diamond lattice	ECL	192	Emitter-Coupled Logic
diffusion	51, 328	diffusion	EEPROM	259	Electrically-Erasable Program- mable Read-Only-Memory
diffusionsekvationen	55	diffusion equation	effektförbrukning	236	power dissipation
diffusionskapacitans	109	diffusion capacitance	effekt-fördräjningsprodukt	237	speed-power product
diffusionskonstant	51, 330	diffusion coefficient	effektiv massa	18	effective mass
diffusionslängd	55	diffusion length	effektransistorer	power transistors	power transistors
diffusionsström	51	diffusion current	bipolärt	184	bipolar
diod	60	diode	DMOS	263	DMOS
efterledningstid	112	storage time, recovery time	VMOS	263	VMOS
genombrott	100	breakdown	efterledningstid	167	storage time
kapacitans	93	capacitance	egenhalvledare	12	intrinsic semiconductor

egentäthet	12	intrinsic concentration	flatbandskapacitans	280	flatband capacitance
Einstiens relation	52	Einstein relationship	flatbandsspänning	202	flatband voltage
E-k diagram	19	E-k diagram	flatkant	319	wafer flat
ekvivalenta schema		equivalent circuits	FLOTOX	259	floating-gate tunneling-oxide
bipolär transistor	151	bipolar	fonon	26	phonon
diod	87	diode	fosfor	12, 328	phosphorus
fotodiod	132	photo diode	fotodiod	131	photo diode
fototransistor	140	photo transistor	fotoledare	128	photo conductor
JFET	268	JFET	fotolitografi	354	photolithography
MOSFET	222	MOSFET	elektronstråle	357	electron-beam
solcell	137	solar cell	optisk	354	optical
electromigration	352	electromigration	röntgen	357	X-ray fotomask
elektron	18	electron	fotomask	303, 354	photo mask
elektronaffinitet	44	electron affinity	fotomotstånd	128	photo conductor
elektronstråleförångning	350	electron-beam evaporation	foton	126	photon
elektronstrålelitografi	357	electron-beam lithography	fotoresist	358	photoresist
elektronstrålemikroskop	373	scanning electron-beam microscope (SEM)	fototransistor	139	photo transistor
elektronvolt	15	electron volt	fotovoltaisk effekt	132	photovoltaic effect
emitter	146, 201	emitter, source	framspänning	65	forward bias
emitter crowding	182	emitter crowding	fri medelvägslängd	26	mean free path
emitterkopplad logik	192	Emitter-Coupled Logic, ECL	funktionskontroll	372	functionality test
emitter-push effekt	336	emitter-push effect	fyrpunktprobe	25	four-point probe
emittertidskonstant	169	forward transit time	fågelnäbb	346	bird's beak
energiband	16	energy band	fälla	130	trap
energibanddiagram	17	energy band diagram	fälteffekttransistor	201	Field Effect transistor (FET)
enhancement-transistor	216	enhancement transistor	JFET	264	JFET
epitaxi	346	epitaxial growth	MESFET	269	MESFET
epitaxiellt skikt	346	epitaxial layer	MOSFET	201	MOSFET
EPROM	259	Erasable Programmable Read-Only-Memory	fältioxid	305, 326	field oxide
erfc	331	complementary error function	förbjudet band	16	forbidden bandgap
etsning	359	etching	fördelningsfunktion	36	distribution function
eutektikum	363	eutectic	Boltzmann	36	Boltzmann
FAMOS	259	Floating-gate Avalanche-injection MOS	Fermi-Dirac	36	Fermi-Dirac
falltid	167, 235	fall time	födröjning	236	propagation delay
felmekanismer	369	failure mechanisms	förstärkning	156	amplification
feltäthet	366	defect density	förtätning	345	densification
Fermi-Dirac-fördelning	36	Fermi-Dirac distribution	förångning	348	evaporation
ferminivå	36	fermi-level	GaAs	33, 141, 269	gallium arsenide
FET	201	Field Effect Transistor	gate	201	gate
Ficks lag	51, 330	Fick's law	Gaussisk dopningsprofil	331	Gaussian doping profile
			Gauss sats	66	Gauss' law
			Gemensam Emitter (GE)	153	Common-Emitter (CE)
			generation	21, 45	generation

optisk	46	optical	JFET	264	Junction-gate FET
termisk	21, 45	thermal	jonimplantation	336	ion implantation
genombrottspänning	100	breakdown voltage	jonisationsenergi	15	ionization energy
glas	305	glass	jonisationskoefficient	105	ionization coefficient
borsilikatglas	345	boron silicate glass (BSG)			
fosforsilikatglas	345	phosphorus silicate glass (PSG)			
gradvisa kanalapproximationen		gradual channel approximation			
gränsfrekvens	172	cut-off frequency	kanal		channel
Gummelnummer	176	Gummel number	bredd	212, 228	width
Gummel-Poons transistor-modell	175	Gummel-Poon transistor model	bredd/längdförhållande	212	aspect ratio
Halleffekt	32	Hall effect	konduktans	213	conductance
halvledare	11	semiconductor	kort	230	short
Haynes-Schockley	54	Haynes-Schockley	längd	212, 228	length
hybrid- π -schemat	171	hybrid- π -model	smal	231	narrow
hål	18	hole	kanallängdmodulation	231	channel modulation
höginjektion	90	high injection	kapacitans		capacitance
ideala diodekvationen	81	ideal diode equation	diffusions-	109, 168	diffusion
I ² L	192	Integrated Injection Logic	MOS-	202, 277	MOS
inbränning	372	burn-in	parasit-	224	parasitic
indrivning	330	drive-in diffusion	spärrskikts-	93	depletion
infångningstärsnitt	47	capture cross section	överlaps-	224	overlap
ingångsskydd	121	input protection	kapsling	364	packaging
injektion	78	injection	kemisk ytbeläggning	342	Chemical Vapor Deposition (CVD)
inkörningsfel	368	infant mortality	kisel	33, 313	silicon
integrerade kretsar	299	integrated circuits	degenererat	40	degraded
integrerad injektionslogik	192	Integrated Injection Logic (I ² L)	enkristallint	313	monolithic
integrerad Schottky logik	194	Integrated Schottky Logic (ISL)	epitaxiellt	346	epitaxial
intrinsisk		intrinsic	polykristallint	343	polycrystalline
ferminivå	39	Fermi level	kisel-på-safir	348	Silicon-On-Saphire (SOS)
halvledare	12	semiconductor	kiselstyre	225, 309, 344	silicon-gate
(eg egenhalvledare)			kollektor	146, 201	collector, drain
koncentration	12	concentration	kollektortorresistans	158	collector series resistance
(eg egentäthet)			kollektortidkonstant	169	reverse transit time
inversion	204, 279	inversion	komplementär felfunktion	331	complementary error function (erfc)
stark	205	strong	kondensator	93	capacitor
svag	204	weak	konduktivitet	9	conductivity
isoplanar		isoplanar	kontaktpotential	62	contact (built-in) potential
bipolär-transistor	184	bipolar transistor	kontinuitetsekvationen	52	continuity equation
MOS	226, 309	MOS	kortkanaleffekt	230	short channel effect
I ² L	194	I ² L (I ³ L)	kortslutningsström	132	short-circuit current

laddning	9	charge	projektionsmaskpassare	355	projection aligner
laddningskontrollmodellen	107, 167	charge-control model	masstransportfaktor	323	(gas phase) mass transfer coefficient
laddningskopplade skift-register	261	Charge-Coupled Devices (CCD)	massverkans lag	22	law of mass action
lasttransistor	232	load transistor	master-slav	246	master-slave
lateral fotocell	135	lateral photocell	medeltid till fel	368	Mean Time to Failure (MTTF)
lateral PNP-transistor	187	lateral PNP transistor	mellan negativ	303	reticle
lavingenombrott	101	avalanche breakdown	metallstyre	211, 225, 305	metal-gate
lavininjektion	259	avalanche injection	metall-halvledare	117	metal-semiconductor
lavinmultiplikation	101	avalanche multiplication	metallisering	348	metalization
"law-of-the-junction"	74	"law-of-the-junction"	Miller-index	314	Miller indices
layout		layout	Millerkapacitans	238	Miller capacitance
bipolär	182	bipolar	minnen	248	minnen
MOS	227	MOS	DRAM	254	DRAM
LED	141	Light-Emitting Diode	EEPROM	259	EEPROM
ledningsband	16	conduction band	EPROM	259	EPROM
ledningsförmåga	9	conductivity	PROM	257	PROM
likriktarverkningsgrad	116	rectification efficiency	ROM	256	ROM
linjebredd	226, 354	linewidth	SRAM	248	SRAM
linjär PN-övergång	71	graded junction	testning	374	testing
linjär tillväxtkonstant	326	linear rate constant	minoritetsbärare	13	minority carrier
litografi	354	lithography	mobilitet (rörlighet)	26	mobility
livslängd (eg livstid)	46	life time	Moores första lag	299	Moore's first law
logik	241	logic	MOS	201	Metal Oxide Semiconductor
CMOS	241	CMOS	MOS-kapacitans	202, 277	MOS-capacitance
DTL	121	DTL	högfrekvent	282	high frequency
ECL	192	ECL	kvasistatisch	281	quasi-static
I²L	192	I ² L	MOS-transistor	201	MOS-transistor
MOS	241	MOS	floating-gate	258	floating gate
TTL	188	TTL	inverterare	232	inverter
LSI			karakteristik	209, 219	characteristic
lokal oxidation	309, 345	Large Scale Integration	kortkanal	230	short channel
		localized oxidation of silicon	logik	241	logic
		(LOCOS)	minnen	248	memories
lysdiod	141	Light-Emitting Diode (LED)	skalning	246	scaling
läckström	82	leakage current	motstånd	186	resistor
läsminne	256	ROM	diffunderade	186	diffused
löptid	130, 169, 223	transit time	pinch	186	pinched
lösighet	329	solid solubility	multiplikationsfaktor	104	multiplication factor
magnetronputter	352	magnetron sputter	mättnadsområde	213	saturation region
majoritetsbärare	13	majority carrier	mättnadsström	157, 213,	
maskpassare	354	mask aligner		221, 266	
DSW	356	direct-step-on-wafer	mönstergenerator	302	saturation current
kontaktkopiator	354	contact printer	mörkerström	131	pattern generator (PG)
					dark current

NAP	124, 197, 275	Nonlinear Analysis Program		
nedskalning	246	scaling	RAM	248
nitrid	345	nitride	refresh	254
N-kanal	201	N-channel	rekombination	21, 45
NMOS	216	N-channel MOS	rekombinationsbegränsad	
N-typ	12	N-type	ström	87
ohmsk kontakt	118	ohmic contact	rekombinationscentra	47
Ohms lag	9	Ohms law	rekombinationstakt	45
omfördelning av störämnen	327	impurity redistribution	resistansområde	213
optisk generation	46	optical generation	resistivitet	9
optokopplare	143	opto coupler	ROM	256
oxid	201	oxide	rörlighet	26
oxidation	320	oxidation	volyms-	26
oxidkapacitans	205, 279	oxide capacitance	yt-	212
oxidladdning	208, 285	oxide charge		
parabolisk tillväxtkonstant	324	parabolic rate constant	Schottky	
parasitkapacitans	224	parasitic capacitance	barriär	117
passivering	305	passivation	diod	117
PECVD	343	Plasma-Enhanced CVD	klamp	170, 189
periodiska systemet	12	periodic table of the elements	transistor	170, 189
P-ficka	307	P-well	Schottkylogik	189
pinch-off	264	pinch-off	TTL-LS	191
PIN-diód	135	PIN-diode	TTL-ALS	191
P-kanal	201	P-channel		
planarteknik	302	planar technology	ISL	194
Plancks konstant	15, 376	Planck's constant	I²L-STL	194
plasma		plasma	segregationskoefficient	315, 327
deponering	343	deposition	serieresistans	85
etsning	360	etching	sidoväggskapacitans	226
PN-övergång		PN junction	självregisterande	225, 337
abrupt	60	abrupt	skalning	246
linjär	71	linearly graded	skiftregister	244
Poissons ekvation	67	Poisson's equation	skiva	305
polystyre	225, 309, 344	poly-gate	skivprocesser	305, 382
potentialbarriär	62	potential barrier	skivsats	305
potentialgröp	261, 293	potential well	skyddssband	307
projicerat medeldjup	339	projected range	slumpmässiga fel	366
PROM	257	Programmable Read Only Memory	småsignal	86, 156, 171, 268
P-typ	13	P-type		
punch-through	161	punch-through	snabbhet	speed
PVD	348	Physical Vapor Deposition	bipolärt	167
			MOS	224, 235
			solcell	137
			solspektrum	138
			source	201

spektralkänslighet	32, 145	spectral response	transistorström	transistor current
SPICE	123, 195, 270	Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis	bipolär	bipolar
spiking	352	spiking	JFET	JFET
spridning	339	straggling	MOSFET	MOSFET
spridningsmekanismer	26	scattering	termisk energi	thermal energy
gitter-	26	lattice	termisk generation	thermal generation
störämnnes-	26	impurity	termistor	thermistor
yt-	212	surface	termoelement	thermo-couple
sputtering	352	sputtering	termokompressionsbondning	thermocompression bonding
spänningsreferens	174	voltage reference	testning	test
spärrskikt	64	depletion-region	testruta för processkontroll	Process Control Monitor (PCM)
spärrskiktskapacitans	93	depletion capacitance	tillförlitlighet	reliability
SRAM	248	Static Random Access Memory	tillståndstäthet	density of states
statisk		static	tomgångsspänning	open-circuit voltage
effektförbrukning	237	power dissipation	totempôle	totem-pole
RAM-minne	248	SRAM	transistorkonstant, k, k'	transistor constant, k, k'
stegtäckning	351	step coverage	transistor-transistorlogik	Transistor-Transistor Logik (TTL)
step-and-repeat	303, 356	step-and-repeat	transkonduktans	transconductance
stigtid	167, 235	rise time	transmissionsgrind	transmission gate
storsignal	86, 156, 222, 268	large-signal	transportmodellen	transport model
strömförstärkning	150	current gain	transportverkningsgrad	transport efficiency
styre	201	gate	tristate	tristate
styreoxid	305, 321	gate oxide	trädbondning	wire bond
störatom	12	impurity atom	trädning	wired-AND
störmarginal	232	noise margin	tröskelspanning	threshold voltage
störnivå	22	impurity level	TTL	Transistor Transistor Logic
störämne	12	impurity dopant	tunneling	tunneling
störämneskoncentration	13	impurity concentration		
substrat	61, 202	substrate	ultraljudsbondning	ultrasonic wire bonding
substrateffekt	217	body-effect	underdiffusion	lateral diffusion
substratfaktor	207	body-factor	underetsning	undercutting
subtröskelström	215	subthreshold current	utarmningsområde	depletion region
temperaturberoende		temperature dependence	utarmningstransistor	depletion transistor
bandgap	43	bandgap	utbyte	(wafer) yield
diodström	91	diode current	utslitningsfel	wear-out failure
genombrottsspänning	103	breakdown voltage	utträdesarbete	work function
intrinsisk koncentration	43	intrinsic concentration		
ledningsförmåga	31	conductivity	vakans	vacancy
motstånd	31	resistor	valensband	valence band
rörlighet	29	mobility	varaktordiod	varactor diode
			V-ficka	V-groove
			VMOS	VMOS
			volymskisel	bulk silicon
			värmebehandling	annealing

ytbeläggning		vapor deposition
epitaxi	346	epitaxy
förångning	348	evaporation
kemisk	342	chemical
ytpolerings	319	surface polishing
ytpotential	203	surface potential
ytreaktionskonstant	323	surface reaction rate coefficient
ytresistans	25	sheet resistance
yttillstånd	293	surface state
zenerdiod	101	zener diode
zenergenombrott	101	zener breakdown
zenerspänning	101	zener voltage
Zerbst plot	292	Zerbst' plot
zonsmälta	317	float-zone
Ångström	376	Angstrom (A°)
återhämtningstid	112	reverse recovery time
åtkomsttid	248	access time
ögats känslighet	32, 145	spectral response of the eye
överföringskarakteristik	156	transfer characteristic
överlappskapacitans	224	overlap capacitance